

دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه کارشناسی ارشد
مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت مواد

ایجاد و بررسی خواص پوشش فانوساخtar تیتانیا بر روی زمینه‌های تیتانیمی به روش رسوب‌نشانی الکتروفورتیک

نگارنده:

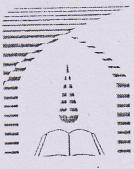
آراز بزدیزاد

استاد راهنما:

دکتر علیرضا صبور روح اقدم

استاد مشاور:

دکتر تقی شهرابی فراهانی



بسم الله الرحمن الرحيم

تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان نامه

آقای آراز یزدی زاد پایان نامه ۶ واحدی خود را با عنوان ایجاد و بررسی خواص

پوشش نانو ساختار تیتانیا بر روی زمینه های تیتانیمی به روش رسوب نشانی

الکتروفورتیک در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ ارائه کردند.

اعضای هیات داوران نسخه نهایی این پایان نامه را از نظر فرم و محتوا تایید کرده و پذیرش آنرا برای تکمیل درجه کارشناسی ارشد مهندسی مواد - خوردگی پیشنهاد می کنند.

عضو هیات داوران	نام و نام خانوادگی	رتبه علمی .	اعضای هیات داوران
استاد راهنمای	دکتر علیرضا صبور روح اقدم	دانشیار	
استاد مشاور	دکتر تقی شهرابی فراهانی	استاد	
استاد ناظر	دکتر محمود علی اف حضرابی	استادیار	
استاد ناظر	دکتر کوروش جعفرزاده	استادیار	
مدیر گروه (یا نماینده گروه تخصصی)	دکتر تقی شهرابی فراهانی	استاد	

این نسخه به عنوان تاییده شهادت پایان نامه در تایید است.

استاد راهنمای:

دستورالعمل حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشی‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه: با عناصریت به سیاست‌های پژوهشی دانشگاه در راستای تحقق عدالت و کرامت انسانها که لازمه شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگران، لازم است اعضای هیات علمی، دانشجویان، دانش آموختگان و دیگر همکاران طرح، در مورد نتایج پژوهشی‌های علمی که تحت عنوانین پایان‌نامه، رساله و طرحهای تحقیقاتی که با هماهنگی دانشگاه انجام شده است، موارد ذیل را رعایت نمایند:

ماده ۱ - حقوق مادی و معنوی پایان‌نامه‌ها / رساله‌های مصوب دانشگاه متعلق به دانشگاه است و هرگونه بهره‌برداری از آن باید با ذکر نام دانشگاه و رعایت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب دانشگاه باشد.

ماده ۲ - انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از پایان‌نامه / رساله به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجتمع علمی باید به نام دانشگاه بوده و استاد راهنما مسئول مکاتبات مقاله باشد.

تبصره: در مقالاتی که پس از دانش آموختگی بصورت ترکیبی از اطلاعات جدید و نتایج حاصل از پایان‌نامه / رساله نیز منتشر می‌شود نیز باید نام دانشگاه درج شود.

ماده ۳ - انتشار کتاب حاصل از نتایج پایان‌نامه / رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه باید با مجوز کتبی صادره از طریق حوزه پژوهشی دانشگاه و بر اساس آئین نامه‌های مصوب انجام می‌شود.

ماده ۴ - ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه در جشنواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که حاصل نتایج مستخرج از پایان‌نامه / رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنما یا مجری طرح از طریق حوزه پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.

ماده ۵ - این دستورالعمل در ۵ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۳۸۴/۴/۲۵ در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و هرگونه تخلف از مفاد این دستورالعمل، از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری می‌شود.

نام و نام خانوادگی

امضاء

آیین نامه چاپ پایان نامه (رساله) های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه (رساله) های تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، مبین بخشی از فعالیتهای علمی - پژوهشی دانشگاه است بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه، دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می شوند:

ماده ۱: در صورت اقدام به چاپ پایان نامه (رساله) خود، مراتب را قبلاً به طور کتبی به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اطلاع دهد.

ماده ۲: در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه) عبارت ذیل را چاپ کند:

«کتاب حاضر، حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد / رساله دکتری نگارنده در رشته دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی سرکار خانم / جناب آقای دکتر و مشاوره سرکار خانم / جناب آقای دکتر از آن دفاع شده است.»

ماده ۳: به منظور جبران بخشی از هزینه های انتشارات دانشگاه، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت چاپ) را به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اهدا کند. دانشگاه می تواند مازاد نیاز خود را به نفع مرکز نشر درعرض فروش قرار دهد.

ماده ۴: در صورت عدم رعایت ماده ۳، ۵۰٪ بهای شمارگان چاپ شده را به عنوان خسارت به دانشگاه تربیت مدرس، تأديه کند.

ماده ۵: دانشجو تعهد و قبول می کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت، دانشگاه می تواند خسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشگاه حق می دهد به منظور استیفای حقوق خود، از طریق دادگاه، معادل وجه مذکور در ماده ۴ را از محل توقیف کتابهای عرضه شده نگارنده برای فروش، تامین نماید.

دانشجوی رشته

ماده ۶: اینجانب

مقطع

تعهد فوق وضمانت اجرایی آن را قبول کرده، به آن ملتزم می شوم.

نام و نام خانوادگی:

تاریخ و امضا:

بسم الله الرحمن الرحيم

تقدیم :

برادر عزیزم

مشکر و قدردانی

در ابتدا از استاد راهنمای عزیز و گران قدر، جناب آقا^ی دکتر صبور روح اقدم برای به راهنمایی‌های مشغله و رهنمودهای سازنده و روشنکر اذشان در انجام پیمان نامه، **سمیانه سپاسگزارم.**

از استاد مشور محترم و گرامی جناب آقا^ی دکتر شهرابی فراهنی به دلیل گهک‌های فراواشان در انجام این پیمان نامه کمال مشکر و قدرانی را دارم.

از آقا^ی دکتر علی اف خضرابی برای گهک و راهنمایی‌شان در مسیر انجام پیمان نامه **سمیانه مشکر می‌کنم.**
از محبت‌های گهک‌های تمای دوستان عزیزم در گروه خودگی و حافظت مواد بالاخص آقایان منصور بزرگ و مرتضی فرنخی راد و خانم سمیرا محمودی **سمیانه سپاسگزارم.**
و در آخر ولی معلم تراز همه از خانواده عزیزم که بهیشه خودم را مدیون محبت بی‌دین و پشتیبانی‌شان می‌دانم **سمیانه و خالصانه مشکر می‌کنم.**

چکیده

در این پژوهش رسوب‌نشانی الکتروفورتیک نانوذرات تیتانیا بر روی زمینه‌های تیتانیم خالص و تیتانیم حاوی پوشش اکسیداسیون میکروآرک مورد بررسی قرار گرفته است.

فرآیند اکسیداسیون میکرو آرک برای به دست آوردن زمینه‌های زبر و متخلخل در دو دانسیته جریان 25 mA/cm^2 و 50 mA/cm^2 در الکتروولیت آبی حاوی سدیم فسفات و سدیم کربنات در زمان 10 دقیقه انجام شد. مورفولوژی و ریزساختار، ضخامت، زبری و مقاومت خوردگی پوشش‌های حاصل مورد بررسی قرار گرفت.

پس از آزمایش‌های پایداری و اندازه‌گیری پتانسیل زتا برای متانول، اتانول و بوتانول با غلظت‌های مختلفی از تری اتانول آمین، سوسپانسیون بهینه انتخاب شد و برای فرآیند رسوب‌نشانی الکتروفورتیک مورد استفاده قرار گرفت.

رسوب‌نشانی الکتروفورتیک در ولتاژ‌های $20\text{, }40\text{, }5\text{ و }60\text{ و زمان‌های }1\text{, }3\text{ و }7\text{ دقیقه}$ با استفاده از جریان مستقیم بر روی 3 نوع زمینه تیتانیم خالص و تیتانیم حاوی پوشش اکسیداسیون میکروآرک ایجاد شده در دو دانسیته جریان مختلف انجام شد. سیتیک فرآیند مورد تحقیق قرار گرفت و ضخامت و دانسیته فشردگی پوشش‌های الکتروفورتیک محاسبه شد. مورفولوژی و ریزساختار پوشش‌ها به وسیله میکروسکوپ نوری و SEM بررسی شد. تصاویر SEM نشان داد که پوشش‌های حاصل نانوساختار هستند و آگلomerهای درشت در ریزساختار وجود ندارند. برای افزایش فشردگی ساختار و همچنین بهبود خواص مکانیکی پوشش، عملیات حرارتی در دمای 800°C به مدت 2 ساعت انجام شد. استحکام چسبندگی پوشش‌ها بر روی زیرلایه‌های مختلف اندازه‌گیری شد و آزمون‌های خوردگی در محلول $\text{NaCl}\text{ ۳/۵٪}$ وزنی انجام گرفت. فعالیت فتوکاتالیستی پوشش، قبل و بعد از عملیات حرارتی توسط اندازه‌گیری میزان زوال متیلن بلو تحت تابش پرتو UV با طول موج 360 نانومتر اندازه‌گیری شد.

نتایج نشان داد که اعمال فرآیند اکسیداسیون میکروآرک بر روی زمینه باعث کاهش ترک‌های ماکروسکوپی پوشش الکتروفورتیک حین خشک شدن و عملیات حرارتی می‌شود و دانسیته فشردگی پوشش را بالا می‌برد و استحکام چسبندگی پوشش را تا 2 برابر و مقاومت خوردگی آن را تا 8 برابر افزایش می‌دهد. پوشش الکتروفورتیک حاصل در ولتاژ $20\text{ و زمان }3\text{ دقیقه}$ بر روی زمینه MAO ایجاد شده در دانسیته جریان 25 mA/cm^2 به عنوان پوشش بهینه انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها: رسوب‌نشانی الکتروفورتیک، اکسیداسیون میکروآرک، نانوذرات تیتانیا، ریزساختار، فعالیت فتوکاتالیستی، بوتانول، TEA

فهرست مطالب

عنوان.....	
صفحه.....	
فصل اول: مقدمه.....	۱
فصل دوم: مروری بر منابع.....	۵
۶-۱- رسم نشانی الکتروفورتیک	۶
۶-۱-۱- تاریخچه	۶
۶-۱-۲- تعریف رسم نشانی الکتروفورتیک	۶
۶-۱-۳- عوامل مؤثر در فرآیند رسم نشانی الکتروفورتیک	۸
۸-۱- متغیرهای مربوط به سوسپانسیون.....	۸
۸-۲- حلال	۸
۹-۱- اندازه ذرات.....	۹
۱۱-۳- ثابت دی الکتریک مایع	۱۱
۱۲-۴- هدایت الکتریکی سوسپانسیون.....	۱۲
۱۲-۵- ویسکوزیتی سوسپانسیون.....	۱۲
۱۳-۶- پتانسیل زتا.....	۱۳
۱۵-۷- پایداری سوسپانسیون.....	۱۵
۱۸-۲-۳- پارامترهای موثر بر فرآیند	۱۸
۱۸-۱-۲-۳- تأثیر زمان رسم دهی	۱۸
۱۹-۲-۲- تأثیر ولتاژ اعمالی	۱۹
۲۱-۴- سیستمیک رسم نشانی الکتروفورتیک	۲۱
۲۵-۱-۵- نحوه باردار شدن ذرات در سوسپانسیونهای آلی	۲۵
۲۶-۱-۵-۱- افزودنیها برای باردار شدن ذرات	۲۶
۲۸-۱-۶- مشخصات سوسپانسیون در فرآیند رسم نشانی الکتروفورتیک	۲۸
۲۸-۱-۶-۱- لایه دوگانه الکتریکی و تحرك الکتروفورتیکی	۲۸
۳۱-۲-۶-۲- تئوری DLVO و پایداری سوسپانسیون	۳۱
۳۲-۷- مکانیزمهای پوشش دهی الکتروفورتیک	۳۲
۳۲-۱-۷-۱- انعقاد در اثر تجمع ذرات	۳۲
۳۳-۲-۷-۱- مکانیزم خشی شدن بار ذره	۳۳
۳۳-۳-۷-۱- مکانیزم انعقاد الکتروشیمیابی ذره.....	۳۳

۳۴	۱-۲-۷-۴- مکانیزم اعوجاج و نازک شدن لایه دوگانه الکتریکی
۳۵	۲-۱-۸- سیترینگ
۳۶	۲-۱-۸-۱- نیروی محرکه سیترینگ
۳۷	۲-۱-۱-۸-۱- انحنای سطح
۳۷	۲-۱-۸-۱-۲- فشار اعمالی
۳۸	۲-۱-۸-۱-۲- واکنش شیمیایی
۴۲	۲-۲- پوشش‌های اکسیداسیون میکرو آرک (MAO)
۴۳	فصل سوم: مواد و روش تحقیق
۴۴	۳-۱- مواد شیمیایی
۴۴	۳-۲- آماده سازی زیرلایه‌ها
۴۴	۳-۱-۲-۳- زیرلایه‌های تیتانیم خالص
۴۴	۳-۲-۲-۳- زیرلایه‌های حاوی پوشش اکسیداسیون میکروآرک
۴۶	۳-۳- تهیه سوسپانسیونها
۴۷	۳-۱-۳-۳- هدایت الکتریکی
۴۸	۳-۲-۳-۳- اندازه گیری پتانسیل زتا
۴۸	۳-۳-۳-۳- آنالیز FT-IR
۴۹	۳-۴- رسوب نشانی الکتروفورتیک
۵۰	۳-۱-۴- بررسی سیستیک فرآیند رسوب نشانی الکتروفورتیک
۵۰	۳-۴-۲- ضخامت پوشش‌های رسوبی
۵۰	۳-۴-۳- تغییرات دانسیته جریان در فرآیند رسوب نشانی الکتروفورتیک
۵۱	۳-۵- عملیات حرارتی پوششها
۵۱	۳-۶- ریزساختار و مورفولوژی پوشش‌های رسوبی
۵۱	۳-۷- بررسی استحکام چسبندگی پوشش به زیرلایه
۵۲	۳-۸- مقاومت خوردگی پوشش‌های رسوبی
۵۲	۳-۹- فعالیت فتوکاتالیستی پوششها
۵۴	۳-۱۰- فلوچارت تحقیق
۵۵	فصل چهارم: نتایج و بحث

۴-۱- بررسی خصوصیات پوشش اکسیداسیون میکروآرک ۵۶	۴
۴-۱-۱- بررسی روند تغییرات ولتاژ در فرآیند اکسیداسیون میکروآرک ۵۶	۴
۴-۱-۲- مورفولوژی سطح پوشش اکسیدی میکروآرک ۵۷	۴
۴-۱-۳- زبری و ضخامت پوششهای اکسیدی میکروآرک ۶۰	۴
۴-۲- مطالعه سوسپانسیونهای رسوب نشانی الکتروفورتیک ۶۱	۴
۴-۲-۱- آماده سازی سوسپانسیون ۶۱	۴
۴-۲-۲- مکانیزم باردار شدن ذرات در سوسپانسیون بدون افزودنی ۶۲	۴
۴-۲-۳- بررسی پایداری سوسپانسیونها ۶۳	۴
۴-۲-۴- مکانیزم عملکرد TEA ۶۵	۴
۴-۲-۵- جذب توزیع کننده در سطح نانو ذرات تیتانیا ۶۶	۴
۴-۲-۶- تغییرات پتانسیل زتای ذرات بر حسب غلظت افزودنی TEA ۶۷	۴
۴-۳- رسوب نشانی الکتروفورتیک ۶۹	۴
۴-۳-۱- تأثیر ولتاژ و زمان فرآیند پوشش دهی بر مشخصات پوشش ۶۹	۴
۴-۳-۲- تأثیر ولتاژ و زمان فرآیند بر ضخامت پوشش ۷۳	۴
۴-۳-۳- تأثیر ولتاژ و زمان فرآیند بر دانسیته فشردگی پوشش ۷۶	۴
۴-۳-۴- بررسی تغییرات دانسیته جریان حین پوشش دهی الکتروفورتیک ۸۲	۴
۴-۴- عملیات حرارتی ۸۵	۴
۴-۵- استحکام چسبندگی ۸۶	۴
۴-۶- بررسیهای میکروسکوپی ۸۹	۴
۴-۶-۱- بررسی ساختار ترکها ۸۹	۴
۴-۶-۱-۱- تأثیر ولتاژ فرآیند الکتروفورتیک بر ساختار ترکها ۸۹	۴
۴-۶-۲- بررسی ریزساختار پوششها ۹۳	۴
۴-۶-۲-۱- تأثیر ولتاژ فرآیند بر ریزساختار پوشش ۹۳	۴
۴-۶-۲-۲- اثر زمان رسوب نشانی بر روی ریزساختار پوششها ۹۵	۴
۴-۶-۲-۳- اثر غلظت افزودنی بر روی ریزساختار پوششها ۹۶	۴
۴-۶-۴- تأثیر عملیات حرارتی ۹۷	۴
۴-۷- آزمونهای خوردگی ۹۹	۴

۹۹.....	۴-۱-۷-بررسی تأثیر فرآیند اکسیداسیون میکرو آرک
۱۰۳.....	۴-۲-آزمون خوردگی پوششهای EPD بر روی زمینه‌های مختلف
۱۰۴.....	۴-۳-بررسی تأثیر زمان فرآیند الکتروفورتیک
۱۰۵.....	۴-۸-انتخاب پوشش بهینه
۱۰۶.....	۴-۹-فعالیت فتوکاتالیستی
۱۰۹.....	فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۱۱۰.....	۵-۱-نتیجه گیری
۱۱۲.....	۵-۲-پیشنهادها
۱۱۳.....	۶-مراجع
۱۱۹.....	مقالات مستخرج از پایان نامه

فهرست اشکال

..... ۷	شكل ۱-۲- شماتیک فرآیند رسوب نشانی الکتروفورتیک. الف) EPD کاتدی ب) EPD آندی.
..... ۱۰	شكل ۲-۲- تصویر SEM YBCO رسوب یافته به روش الکتروفورتیک بر روی نقره از سوسپانسیون استونی در ولتاژ ۱۰ ولت و زمان ۱۸۰ ثانیه. الف) اندازه ذرات ۶۰ نانومتر و ب) اندازه ذرات ۳ میکرومتر.
..... ۱۵	شكل ۳-۲- پتانسیل زتا و هدایت الکتریکی سوسپانسیون PZT در pHهای مختلف.
..... ۱۹	شكل ۴-۲- رابطه بین ضخامت رسوب و زمان رسوب برای پوشش‌های ZnO بر روی الکترود مس در پتانسیلهای اعمالی مختلف.
..... ۱۹	شكل ۵-۲- نمودار دانسیته جریان بر حسب زمان رسوبنشانی برای رسوب هیدروکسی آپاتیت در ولتاژهای مختلف (a) ۵۰ و (b) ۲۰۰.
..... ۲۰	شكل ۶-۲- وزن رسوب ایجاد شده از هیدروکسی آپاتیت بر روی زیرلایه Ti6Al4V بر حسب ولتاژ اعمالی در زمانهای مختلف رسوبنشانی (a) ۳۰ و (b) ۱۲۰ ثانیه.
..... ۲۱	شكل ۷-۲- نمایش سیستیک فرآیند رسوب نشانی الکتروفورتیک در چند حالت مختلف به صورت شماتیک.
..... ۲۷	شكل ۸-۲- نمایش مکانیزم پایداری الکترواستاتیک(a) و استریک(b) به صورت شماتیک.
..... ۲۹	شكل ۹-۲- شماتیک لایه دوگانه و افت پتانسیل در امتداد لایه دوگانه (a) بار سطحی (b) لایه نفوذی یون‌های با بار مخالف.
..... ۳۲	شكل ۱۰-۲- انرژی کلی بر همکنش بین ذرات کروی به عنوان تابعی از فاصله بین ذره‌ای بر اساس تئوری DLVO.
..... ۳۵	شكل ۱۱-۲- نمایش شماتیکی مکانیزم رسوب ناشی از اعوجاج و نازک شدن لایه دوگانه الکتریکی.
..... ۴۰	شكل ۱۲-۲- دیاگرام ولتاژ-جریان برای فرآیند اکسیداسیون میکروآرک.
..... ۴۵	شكل ۱-۳- شماتیک فرآیند اکسیداسیون میکروآرک.
..... ۴۹	شكل ۲-۳- تصویر سل و یکسوکننده مورد استفاده در فرآیند رسوب نشانی الکتروفورتیک.
..... ۵۳	شكل ۳-۳- شماتیک محفظه تابش نور UV
..... ۵۶	شكل ۱-۴- نمودار ولتاژ-زمان برای فرآیند MAO بر روی تیتانیم خالص با دو دانسیته جریان ثابت ۲۵ و ۵۰ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع.
..... ۵۸	شكل ۲-۴- تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح پوشش ایجاد شده از فرآیند اکسیداسیون میکروآرک بر روی تیتانیم در دانسیته جریان ۲۵ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع.
..... ۵۸	شكل ۳-۴- تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح پوشش ایجاد شده از فرآیند اکسیداسیون میکروآرک بر روی تیتانیم در دانسیته جریان ۵۰ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع.
..... ۵۹	شكل ۴-۴- طیف آزمون EDS پوشش‌های اکسیداسیون میکروآرک ایجاد شده در دانسیته های الف) 25 mA/cm^2 و ب) 50 mA/cm^2

..... شکل ۴-۵- نمودار زبری پوشش به دست آمده از فرآیند اکسیداسیون میکروآرک در دانسیته جریان (الف) ۲۵ و (ب) ۵۰ میلی آمپر بر سانتی متر مربع. ۶۰
..... شکل ۴-۶- نمودار ستونی آزمون ته نشینی سوسپانسیونهای تهیه شده از الکلها م مختلف پس از ۳۰ روز (غلظت تیتانیا ۱۰ گرم بر لیتر). ۶۱
..... شکل ۴-۷- نمودار ستونی آزمون ته نشینی سوسپانسیونهای بوتانلی حاوی غلظتهای مختلف TEA پس از ۳۰ روز (غلظت تیتانیا ۱۰ گرم بر لیتر). ۶۴
..... شکل ۴-۸- تغییرات هدایت الکتریکی سوسپانسیون بوتانلی با غلظت 1 g/l تیتانیا بر حسب میزان افزودنی TEA. ۶۵
..... شکل ۴-۹- طیفهای به دست آمده از آزمایش FT-IR پودر جدا شده از سوسپانسیون بوتانلی بدون افزودنی و حاوی میزان بهینه افزودنی TEA. ۶۷
..... شکل ۴-۱۰- نمودار تغییرات پتانسیل زتا نانو ذرات تیتانیای موجود در سوسپانسیون بر حسب غلظت TEA. ۶۸
..... شکل ۴-۱۱- نمودار هدایت الکتریکی و پتانسیل زتا بر حسب غلظت افزودنی TEA. ۶۹
..... شکل ۴-۱۲- نمودار تغییرات وزن پوششهای الکتروفورتیک ایجاد شده بر روی زیرلایه های Ti, MAO ۲۵ mA/cm ² و MAO ۵۰ mA/cm ² در ولتاژهای مختلف رسوب نشانی. ۷۱
..... شکل ۴-۱۳- نمودار تغییرات ضخامت پوششهای الکتروفورتیک ایجاد شده بر روی زیرلایه های Ti و MAO ۲۵ mA/cm ² و MAO ۵۰ mA/cm ² در ولتاژهای مختلف رسوب نشانی. ۷۵
..... شکل ۴-۱۴- نمایش شماتیک نحوه تغییرات دانسیته فشردگی پوشش بر حسب زمان در ولتاژهای مختلف. ۷۷
..... شکل ۴-۱۵- نمودار تغییرات دانسیته فشردگی پوششهای ایجاد شده بر روی زیرلایه های مختلف با گذشت زمان در ولتاژهای مختلف رسوب نشانی. ۸۰
..... شکل ۴-۱۶- نمودار تغییرات دانسیته فشردگی پوششها با گذشت زمان برای زیرلایه های مختلف در ولتاژ ثابت. ۸۲
..... شکل ۴-۱۷- منحنی تغییرات دانسیته جریان رسوب نشانی الکتروفورتیک بر روی زمینه تیتانیم خالص. ۸۳
..... شکل ۴-۱۸- منحنی تغییرات دانسیته جریان رسوب نشانی الکتروفورتیک در ولتاژ ۴۰ بر روی زیرلایه های مختلف. ۸۴
..... شکل ۴-۱۹- طیف پراش اشعه X برای پوشش حاصل از فرآیند الکتروفورتیک در ولتاژ ۴۰ و زمان ۵ دقیقه. ۸۶
..... شکل ۴-۲۰- نمودار ستونی استحکام چسبندگی پوششهای الکتروفورتیک به دست آمده از ولتاژ ۲۰ و زمان ۳ دقیقه بر روی زمینه های مختلف. ۸۷
..... شکل ۴-۲۱- تصویر SEM پوشش حاصل از فرآیند اکسیداسیون میکروآرک ایجاد شده در دانسیته جریان (الف) ۵۰ mA/cm ² و (ب) ۲۵ mA/cm ² . ۸۸
..... شکل ۴-۲۲- بررسی تأثیر ولتاژ اعمالی بر روی ساختار ترکهای پوشش الکتروفورتیک ایجاد شده در زمان ۳ دقیقه. (الف، ب، ج) ۲۰ ولت. (د، ه، و) ۴۰ ولت. (ز، ح، ط) ۶۰ ولت. ۹۱
..... شکل ۴-۲۳- تأثیر عملیات حرارتی بر روی ساختار ترکهای پوشش الکتروفورتیک ایجاد شده در ولتاژ ۲۰ ولت و زمان ۳ دقیقه بر روی زیرلایه های Ti, MAO25 و MAO50. (الف، ب) ۹۲

- شكل ۴-۲۴- بررسی تأثیر ولتاژ رسوب نشانی بر ریزساختار و نحوه چینش ذرات پوشش به دست آمده بر روی زمینه MAO25 در زمان ۳ دقیقه در ولتاژ (الف) ۲۰ (ب) ۴۰ و (ج) ۶۰ ولت..... ۹۳
- شكل ۴-۲۵- ریزساختار پوشش‌های الکتروفورتیک ایجاد شده در زمان‌های (الف) ۱ (ب) ۳ و (ج) ۵ دقیقه در ولتاژ ۴۰..... ۹۵
- شكل ۴-۲۶- ریزساختار پوشش‌های به دست آمده از (الف) سوسپانسیون بدون افزودنی (ب) سوسپانسیون با افزودنی TEA به میزان بهینه (۱/۵ گرم بر لیتر) و (ج) سوسپانسیون با افزودنی بیش از میزان بهینه (۳ گرم بر لیتر) در ولتاژ ۴۰ و زمان ۳ دقیقه..... ۹۶
- شكل ۴-۲۷- تأثیر عملیات حرارتی بر روی ریزساختار پوشش الکتروفورتیک بر روی زمینه MAO25 (الف، ب) ۲۰ ولت. (ج، د) ۶۰ ولت. (الف، ج) قبل از عملیات حرارتی. (ب، د) بعد از عملیات حرارتی..... ۹۸
- شكل ۴-۲۸- منحنی های پتانشیو داینامیک تیتانیم خالص و تیتانیم‌های حاوی پوشش MAO در محلول ۳/۵٪ وزنی NaCl..... ۱۰۰
- شكل ۴-۲۹- منحنی نایکوئیست تیتانیم خالص و تیتانیم‌های حاوی پوشش MAO در محلول ۳/۵٪ وزنی NaCl..... ۱۰۱
- شكل ۴-۳۰- مدار الکتریکی مورد استفاده برای تطبیق داده های امیدانس..... ۱۰۱
- شكل ۴-۳۱- انطباق مدار معادل استفاده شده با داده های تجربی نمودارهای بُد و نمودار امپدانس الکتروشیمیابی برای نمونه Ti..... ۱۰۲
- شكل ۴-۳۲- نمودار پتانشیو داینامیک پوشش الکتروفورتیک ایجاد شده در زمان ۳ دقیقه و ولتاژ ۲ بر روی زمینه های مختلف در محلول ۳/۵٪ وزنی NaCl..... ۱۰۳
- شكل ۴-۳۳- نمودار پلاریزاسیون پوشش‌های الکتروفورتیک ایجاد شده در ولتاژ ۲۰ ولت و زمان‌های ۳ و ۵ دقیقه بر روی زمینه MAO 25..... ۱۰۴
- شكل ۴-۳۴- تصویر SEM پوشش بهینه (زیرلایه MAO (۲۵ mA/cm²) و ولتاژ ۲۰ و زمان ۳ دقیقه برای فرآیند الکتروفورتیک (عملیات حرارتی شده به مدت ۲ ساعت در دمای ۸۰۰°C))...... ۱۰۶
- شكل ۴-۳۵- تغییرات طیف جذب متیلن آبی در اثر تجزیه کنندگی پوشش تیتانیا در زمانهای مختلف از قرار گیری در معرض پرتو UV..... ۱۰۷
- شكل ۴-۳۶- تجزیه رنگ متیلن بلو توسط لایه نازک نانوکریستالی TiO₂ توسط تابش نور UV و در حضور اکسیژن..... ۱۰۷
- شكل ۴-۳۷- تجزیه کنندگی فتوکاتالیستی پوشش تیتانیای حاصل از فرآیند EPD در دو حالت عملیات حرارتی نشده و عملیات حرارتی شده در دمای ۸۰۰ به مدت ۲ ساعت..... ۱۰۸

فهرست جداول

جدول ۱-۳- ترکیب شیمیابی فلز تیتانیم به کار گرفته شده به عنوان زیرلایه.....	۴۳
جدول ۲-۳- مشخصات پودر تیتانیا به کار برده شده در پژوهش.....	۴۳
جدول ۳-۳ مشخصات حلال مورد استفاده در سوسپانسیون فرآیند رسوب نشانی الکتروفورتیک.	۴۴
جدول ۴-۱- ترکیب عناصر موجود در پوشش اکسیداسیون میکروآرک.	۵۹
جدول ۴-۲- وزن پوشش‌های الکتروفورتیک ایجاد شده بر روی زیرلایه‌های (الف) Ti (ب) MAO 25 mA/cm ² و (ج) MAO 50 mA/cm ² در ولتاژها و زمانهای مختلف رسوب نشانی (اعداد بر حسب میلی گرم است).	۷۰
جدول ۴-۳- ضخامت پوشش‌های الکتروفورتیک ایجاد شده بر روی زیرلایه‌های (الف) Ti (ب) MAO 25 mA/cm ² و (ج) MAO 50 mA/cm ² در ولتاژها و زمانهای مختلف رسوب نشانی بر حسب میکرومتر.	۷۴
جدول ۴-۴- دانسیته فشردگی پوشش‌های الکتروفورتیک ایجاد شده بر روی زیرلایه‌های (الف) Ti (ب) MAO 25 mA/cm ² و (ج) MAO 50 mA/cm ² در ولتاژها و زمانهای مختلف رسوب نشانی (درصد).	۷۹
جدول ۴-۵- مقادیر عددی استحکام چسبندگی پوشش‌های الکتروفورتیک به دست بر روی زمینه‌های مختلف.	۸۶
جدول ۴-۶- مقادیر عددی پارامترهای خوردگی زیرلایه‌های مختلف در محلول ۳/۵٪ وزنی NaCl.	۹۹
جدول ۴-۷- مقادیر مقامت خوردگی (Rp) تیتانیم خالص و تیتانیم‌های حاوی پوشش MAO در محلول ۳/۵٪ وزنی NaCl	۱۰۲
جدول ۴-۸- مقادیر نرخ خوردگی و دانسیته جریان خوردگی پوشش الکتروفورتیک ایجاد شده در زمان ۳ دقیقه و ولتاژ ۲ بر روی زمینه‌های مختلف در محلول ۳/۵٪ وزنی NaCl.	۱۰۳
جدول ۴-۹- مقادیر عددی پارامترهای خوردگی مربوط به نمودار پلاریزاسیون پوشش‌های الکتروفورتیک ایجاد شده در ولتاژ ولت و زمانهای ۳ و ۵ دقیقه بر روی زمینه 25 MAO	۲۰۴

فصل اول

مقدمه

فیلم‌های دی‌اکسیدتیتانیم با کاربردهای فراوان و گسترده از جمله کاربردهای الکتریکی، فتوکاتالیستی، سیستم‌های الکتروشیمیایی، باتری‌های لیتیومی، سلول‌های خورشیدی، پیل‌های سوختی و سنسورهای گازی و ... دارای اهمیت فراوان هستند.

روش‌های گوناگونی از جمله کند و پاش^۱، رسوب‌دهی بخار شیمیایی، رسوب‌دهی پرتو الکترونی و رسوب‌دهی فاز مایع و روش سل ژل برای ایجاد پوشش‌های TiO_2 به کار رفته است. رسوب‌نشانی الکتروفورتیک به دلیل سادگی روش، ارزان بودن تجهیزات، کنترل آسان ضخامت فیلم و امکان طراحی هندسه‌های پیچیده در سال‌های اخیر توجه زیادی را در ایجاد فیلم‌های سرامیکی با ضخامت بالا به خود جلب کرده است.

اساس روش EPD بر مبنای حرکت ذرات باردار داخل سوسپانسیون به طرف الکترود با بار مخالف تحت تأثیر یک میدان الکتریکی و سپس رسوب و انعقاد ذرات و تشکیل لایه چگال است.

این فرآیند بستگی به قابلیت پراکنده شدن پودر مورد استفاده، پایداری سوسپانسیون، تحرک الکتروفورتیک ذره و نیروی برهمنش ذرات دارد. بنابراین خاصیت کلوییدی سوسپانسیون از اهمیت بالایی برخوردار است. در کل، سوسپانسیون‌های با پراکنده‌گی زیاد و ذرات با بار الکتریکی بالا پوشش‌های با دانسیته فشرده‌گی بالاتری تولید می‌کنند. تهیه سوسپانسیون‌های کلوییدی پایدار از پودر

¹ sputtering

سرامیکی نیاز به ملاحظات دقیق در فاکتورهای دخیل از جمله انتخاب حلال، افزودن پلی الکترولیت پراکنده‌ساز و بایندر، پتانسیل زتا، مقدار pH، مقاومت یونی و شرایط شیمیایی سطح و پوشش دارد. رسوب‌دهی با استفاده از حلال آبی ممکن است منجر به بروز مشکلاتی از جمله شروع الکترولیز از ولتاژهای پایین گردد. الکترولیز باعث تشکیل حباب می‌گردد که دلیل اصلی بروز حفرات در رسوب است.

معمولًاً برای افزایش تراکم پوشش و بهبود استحکام مکانیکی آن نیاز به یک مرحله عملیات حرارتی بعد از پوشش‌دهی می‌باشد. پوشش‌های الکتروفورتیک معمولًاً به دلیل ایجاد تنفس کششی در سطح حين خشک شدن ترک می‌خورند. میزان این تنفس برای پوشش‌های نانوساختار به دلیل بیشتر بودن فشار موئینگی، بالاتر است. این ترک‌ها در مرحله عملیات حرارتی به دلیل افزایش دانسیته پوشش عریض‌تر می‌شوند. کترول فرآیند و افروden فاز واسط می‌تواند تا حدی از بروز ترک‌ها جلوگیری کند. همچنین محدودیتی که زمینه فلزی در بالا بردن دمای عملیات حرارتی ایجاد می‌کند باعث می‌شود که دمای عملیات حرارتی برای سیتر پوشش سرامیکی کافی نباشد و بنابراین تفاوت در ضریب انبساط حرارتی زمینه فلزی و پوشش سرامیکی باعث کاهش چسبندگی فیلم می‌شود. گاهی با استفاده از عملیات مکانیکی مانند سند بلاست و یا اچ شیمیایی چسبندگی پوشش الکتروفورتیک را افزایش می‌دهند. در مورد پوشش‌های تیتانیا بر روی زمینه تیتانیمی، افروden فاز واسط اکسیدی برای افزایش استحکام پیوند پیشنهاد شده است.

در این تحقیق فرآیند اکسیداسیون میکروآرک با استفاده از جریان مستقیم بر روی تیتانیم خالص انجام گرفته است. پوشش حاصل به عنوان زیرلايه برای رسوب‌نشانی الکتروفورتیک نانوذرات تیتانیا مورد استفاده قرار گرفته است. پوشش‌های حاصل از فرآیند اکسیداسیون میکروآرک غالباً زبر و

متخلخل بوده و با کنترل فرآیند می‌توان به تخلخل‌های به اندازه دلخواه رسید. این فاز واسطه از نوع پوشش‌های تبدیلی است و چسبندگی بالایی به زمینه دارد و از آنجایی که اکسیدی است، اختلاف ضریب انساط حرارتی کمی با پوشش الکتروفورتیک دارد. به علاوه وجود تخلخل‌ها و ترک‌های نانومتری می‌تواند از طریق افزایش سطح مؤثر، نیروی محرکه سیسترنگ را بالا برده و استحکام پیوند نانوذرات تیتانیا با زمینه را بعد از عملیات حرارتی افزایش دهد. پیش‌بینی می‌شود که مجموعه این عوامل در بهبود ساختار و خواص مکانیکی و خوردگی پوشش نهایی الکتروفورتیک مؤثر باشند.